

8050 (3DA8050)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于 2W 乙类推挽功放。

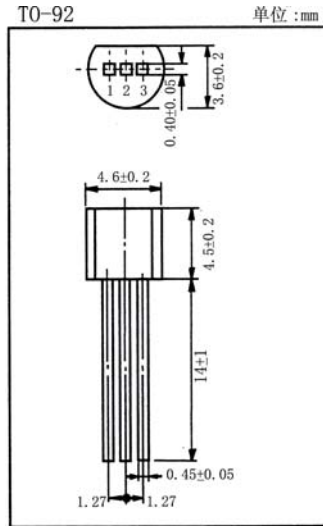
Purpose:2W output amplifier of portable radios in class B push-pull operation.

特点: P_c , I_c 大, 与 8550(3CA8550) 互补。

Features: High P_c and I_c , complementary pair with 8550(3CA8550).

极限参数/Absolute maximum ratings($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	40	V
V_{CE0}	25	V
V_{EB0}	6.0	V
I_c	1.5	A
I_B	0.5	A
P_c	1.0	W
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



引脚: 1. E 2. B 3. C

电性能参数/Electrical characteristics($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_c=0.1\text{mA}$	$I_E=0$	40			V
V_{CE0}	$I_c=2.0\text{mA}$	$I_B=0$	25			V
V_{EB0}	$I_E=0.1\text{mA}$	$I_c=0$	6.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=35\text{V}$	$I_E=0$			0.1	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=6.0\text{V}$	$I_c=0$			0.1	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=1.0\text{V}$	$I_c=100\text{mA}$	85		300	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=1.0\text{V}$	$I_c=800\text{mA}$	40			
$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=1.0\text{V}$	$I_c=5.0\text{mA}$	45			
$V_{CE(sat)}$	$I_c=800\text{mA}$	$I_B=80\text{mA}$		0.28	0.5	V
$V_{BE(sat)}$	$I_c=800\text{mA}$	$I_B=80\text{mA}$		0.98	1.2	V
V_{BE}	$V_{CE}=1.0\text{V}$	$I_c=10\text{mA}$		0.66	1.0	V
f_T	$V_{CE}=10\text{V}$	$I_c=50\text{mA}$	100	200		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$	$I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		15		pF

$h_{FE(1)}$ 分档/ $h_{FE(1)}$ classifications: B:85~160 C:120~200 D:160~300